### การวิเคราะห์อินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรมแบบเต็มบริดจ์ความถี่สูง ที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยการปรับความถี่การสวิทช์

Analysis of High-Frequency Full-Bridge Series Resonant Inverter with Variable Switching Frequency Power Control

ยงยุทธ นาราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Email : yongyuth\_nar@yahoo.com

### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์วงจร อินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรมแบบเต็มบริดจ์ที่ ควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยการปรับความถี่การสวิทซ์ ใน บทความได้อธิบายถึงการทำงานของวงจร อินเวอร์เตอร์ขณะทำงานที่จุดเรโซแนนท์ ต่ำกว่าเร โซแนนท์และสูงกว่าเรโซแนนท์ ทำการวิเคราะห์หา สมการของแรงดันและกระแสเอาท์พุทซึ่งสามารถ นำไปสู่การคำนวณหาสมการของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุท ได้ ยืนยันความถูกต้องของผลทางทฤษฏีด้วยการ ทดลองโดยใช้เครื่องต้นแบบมอสเฟทเรโซแนนท์ อินเวอร์เตอร์ทำงานที่แรงดันดีชีด้านอินพุทเท่ากับ 200 V ย่านการควบคุมความถี่จาก 60-80 kHz ซึ่งมีผลต่อ การควบคุมกำลังไฟฟ้าด้านเอาท์พุทให้อยู่ในย่านจาก 1300-370 W

#### Abstract

This paper presents an analysis of highfrequency full-bridge series resonant inverter circuit with variable switching frequency power control. The circuit operations at resonant, below resonant and above resonant are first discussed. The output voltage and current equations are analyzed, which can lead to the calculation of output power equation. The theoretical results are verified by experiment using a prototype MOSFET resonant inverter running at 200 V DC input voltage, frequency control range from 60-80 kHz effecting output power control range from 1300-370 W.

### 1. บทนำ

อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ความถี่สูงจ่าย โหลดเรโซแนนท์อนุกรมดังแสดงในรูปที่ 1 กำลังได้รับ ความนิยมและมีการประยุกต์ใช้งานหลากหลาย เช่น เครื่องให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ เตาหุงต้มแบบ เหนี่ยวนำ เครื่องหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ เครื่อง เชื่อมความถี่สูง เป็นต้น[4]-[8] เนื่องจากเรโซแนนท์ อินเวอร์เตอร์ทำงานที่ความถี่สูงส่งผลทำให้อุปกรณ์ ต่างๆ ในวงจรมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ส่วนวิธีการลด กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการสวิทช์(switching loss) เนื่องจากอุปกรณ์สวิทช์ของอินเวอร์เตอร์ทำงานด้วย ความถี่สูงนั้นสามารถทำได้โดยใช้เทคนิค soft

การทำงานของอินเวอร์เตอร์ดังกล่าวจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่การสวิทซ์( $f_s$ ) โดยสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ย่านคือย่านความถี่การสวิทซ์ต่ำกว่าความถี่เร โซแนนท์( $f_s < f_0$ )และย่านความถี่การสวิทซ์สูงกว่า ความถี่เรโซแนนท์( $f_s > f_0$ ) กับอีก 1 จุดของความถี่ การสวิทซ์เท่ากับความถี่เรโซแนนท์( $f_s = f_0$ ) โดยใน แต่ละย่านจะมีลำดับการนำกระแสของสวิทซ์มอสเฟท และไดโอดที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการเริ่มนำกระแส (turn on) ของสวิทซ์มอสเฟทว่าจะมีการเริ่มนำกระแส ขณะแรงดันเป็นศูนย์ (ZVS) ซึ่งจะทำให้สวิทซ์ทำงาน ด้วยความปลอดภัยหรือเริ่มนำกระแสขณะแรงดันไม่ เป็นศูนย์ (NON-ZVS) ซึ่งสวิทซ์จะทำงานไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อสวิทซ์ได้[8] รายละเอียด การทำงานทั้งหมดอธิบายได้ดังต่อไปนี้

# 2.1 การทำงานเมื่อความถี่การสวิทซ์ด่ำกว่า ความถี่เรโซแนนท์

เมื่ออินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์จ่ายโหลดเรโซแน นท์อนุกรมทำงานที่ความถี่การสวิทช์ต่ำกว่าความถี่เร โซแนนท์ของวงจร ( $f_s < f_0$ ) ค่าอิมพีแดนซ์ของโหลด สามารถมองได้เป็นคาปาซิทีฟโหลด [1]-[4] ทำให้ กระแสเอาท์พุท( $i_o$ )นำหน้าองค์ประกอบหลักมูลของ แรงดันเอาท์พุท( $v_{o1}$ )หรือจุดตัดศูนย์(zero crossing) ของคลื่นกระแสเอาท์พุทเกิดขึ้นก่อนจุดตัดศูนย์ของ คลื่นแรงดันเอาท์พุท( $v_o$ )ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยในแต่ ละครึ่งไซเคิลของแรงดันเอาท์พุทจะมีโหมดการทำงาน สองโหมดคือ โหมดเพาเวอริ่ง(P)ซึ่งเป็นโหมดการ ทำงานที่มีการขนถ่ายกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายดีชี ผ่านอินเวอร์เตอร์ไปยังโหลด และโหมดรีเจนเนอเรทีฟ (R)เป็นโหมดการทำงานที่มีการขนถ่ายกำลังไฟฟ้า

switching จึงส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของ อินเวอร์เตอร์แบบนี้มีค่าสูง



รูปที่ 1 วงจรอินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์จ่ายโหลดเรโซแนนท์ อนุกรม

ในบทความนี้ได้นำเสนอการวิเคราะห์หา สมการต่างๆ ของวงจรโดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึง หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรม โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห์หาความถี่เรโซแนนท์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรเร โซแนนท์ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเอาท์พุทและการ เปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทเมื่อปรับความถี่ การสวิทซ์ในย่านที่สูงกว่าความถี่เรโซแนนท์

### 2. การทำงานของวงจร

หลักการทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์เต็ม บริดจ์ขณะจ่ายโหลดเรโซแนนท์อนุกรมดังรูปที่ 1 เมื่อ ควบคุมการทำงานของคู่สวิทซ์  $S_1, S'_2$  และคู่สวิทซ์  $S_2, S'_1$  ให้นำกระแสและหยุดนำกระแสสลับกันไปคู่ละ ครึ่งไซเคิลของการสวิทซ์ทำให้ได้แรงดันเอาท์พุท ( $v_o$ ) ของอินเวอร์เตอร์มีลักษณะเป็นคลื่นสแควร์ที่มีความ สูงเท่ากับ  $+V_d$  และ  $-V_d$  สลับกันไปในแต่ละครึ่ง ไซเคิลของคลื่นสแควร์นี้ และถ้าค่า Quality factor (Q) ของโหลดมีค่ามากพอจะทำให้คลื่นกระแส เอาท์พุท( $i_o$ )มีลักษณะใกล้เคียงไซน์ [1]-[3] กลไก กลับจากโหลดคืนไปยังแหล่งจ่ายดีซี สำหรับกรณี f<sub>s</sub> < f<sub>0</sub> นี้จะมีลำดับของโหมดการ



รูปที่ 2 คลื่นแรงดันและกระแสเอาท์พุทพร้อมวงจรแสดงโหมด การทำงานของอินเวอร์เตอร์เมื่อ *f<sub>s</sub> < f*<sub>0</sub>

ทำงานในแต่ละครึ่งไซเคิลของแรงดันเอาท์พุทเป็น โหมดเพาเวอริ่งก่อนแล้วตามด้วยโหมดรีเจนเนอเรทีฟ ซึ่งจะทำให้มีลำดับการนำกระแสของสวิทซ์มอสเฟท (s)และไดโอด(D)ในกิ่งที่หนึ่งของอินเวอร์เตอร์เป็น s<sub>1</sub>-D<sub>1</sub>-s<sub>1</sub>'-D<sub>1</sub> และมีลำดับการนำกระแสของสวิทซ์ มอสเฟทและไดโอดในกิ่งที่สองของอินเวอร์เตอร์เป็น s<sub>2</sub>'-D<sub>2</sub>'-s<sub>2</sub>-D<sub>2</sub> จากการที่ลำดับการนำกระแสของ สวิทซ์มอสเฟทและไดโอดในแต่ละกิ่งเป็นเช่นนี้จะทำ ให้การเริ่มนำกระแสของสวิทซ์มอสเฟทเกิดขึ้นขณะ แรงดันคร่อมสวิทซ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ (non zero voltage switching, NON-ZVS) ตัวอย่างเช่นการเริ่ม นำกระแสของสวิทซ์มอสเฟท s<sub>2</sub> ในโหมดเพาเวอริ่ง ของครึ่งไซเคิลลบของแรงดันเอาท์พุทดังแสดงในรูปที่ 2 จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นกระแสเอาท์พุทไหลผ่าน ไดโอด D<sub>1</sub> และ D'<sub>2</sub> ทำให้มีแรงดันคร่อมสวิทซ์ มอสเฟท S<sub>2</sub> เท่ากับ V<sub>d</sub> ดังนั้นขณะสวิทซ์มอสเฟท S<sub>2</sub> เริ่มนำกระแส (turn on) จึงยังคงมีแรงดันคร่อม สวิทซ์นี้เท่ากับ V<sub>d</sub> นั่นหมายความว่าสวิทซ์มอสเฟท ดังกล่าวทำงานภายใต้สภาวะ NON-ZVS ซึ่งเป็นการ ทำงานที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุทำให้สวิทซ์เกิดความ เสียหายได้

# 2.2 การทำงานเมื่อความถี่การสวิทซ์เท่ากับ ความถี่เรโซแนนท์

เมื่คคินเวคร์เตคร์เต็มบริดจ์จ่ายโหลดเรโซแน นท์อนุกรมทำงานที่ความถี่การสวิทช์เท่ากับความถี่เร โซแนนท์ของวงจร( $f_s=f_0$ ) ค่าอิมพีแดนซ์ของโหลด สามารถมองได้เป็นโหลดความต้านทาน [1]-[4] ทำให้ กระแสเอาท์พุท(i<sub>o</sub>)มีเฟสตรงกันกับองค์ประกอบหลัก มูลของแรงดันเอาท์พุท(v<sub>a1</sub>)หรือจุดตัดศูนย์ของคลื่น กระแสเอาท์พุทเกิดขึ้นพร้อมกันกับจุดตัดศูนย์ของ คลื่นแรงดันเอาท์พุท(v<sub>o</sub>) ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยในแต่ ละครึ่งไซเคิลของแรงดันเอาท์พุทจะมีใหมดการทำงาน เพียงโหมดเดียวคือโหมดเพาเวอริ่ง(P) สำหรับกรณี  $f_s = f_0$  นี้สวิทช์มอสเฟทจะเริ่มน้ำกระแสขณะกระแส เท่ากับศูนย์ ในกรณีนี้ไดโอดที่ต่อขนานกับสวิทช์ มอสเฟทจะไม่มีโอกาสได้น้ำกระแส แต่อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานโดยทั่วไปความถี่การสวิทซ์จะไม่เท่ากับ ความถี่เรโซแนนท์ของวงจร ดังนั้นจึงต้องมีไดโอดต่อ ขนานไว้ในลักษณะ antiparallel เสมอ



รูปที่ 3 คลื่นแรงดันและกระแสเอาท์พุทพร้อมวงจรแสดงโหมด การทำงานของอินเวอร์เตอร์เมื่อ  $f_s = f_0$ 

# 2.3 การทำงานเมื่อความถี่การสวิทซ์สูงกว่า ความถี่เรโซแนนท์

เมื่ออินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์จ่ายโหลดเรโซแน นท์อนุกรมทำงานที่ความถี่การสวิทช์สูงกว่าความถี่เร โซแนนท์ของวงจร( f<sub>s</sub> > f<sub>0</sub>) ค่าอิมพีแดนซ์ของโหลด สามารถมองได้เป็นอินดัคทีฟโหลด [1]-[4] ทำให้ กระแสเอาท์พุท(i<sub>o</sub>)ล้าหลังองค์ประกอบหลักมูลของ แรงดันเอาท์พุท(v<sub>o1</sub>) หรือจุดตัดศูนย์ของคลื่นกระแส เอาท์พุทเกิดขึ้นหลังจุดตัดศูนย์ของคลื่น



รูปที่ 4 คลื่นแรงดันและกระแสเอาท์พุทพร้อมวงจรแสดงโหมด การทำงานของอินเวอร์เตอร์เมื่อ f<sub>s</sub> > f<sub>0</sub>

แรงดันเอาท์พุท(vo) ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยในแต่ละ ครึ่งไซเคิลของแรงดันเอาท์พุทจะมีโหมดการทำงาน สองโหมดคือโหมดเพาเวอริ่ง(P) และโหมดรีเจนเนอเร สำหรับกรณี  $f_s > f_0$  นี้จะมีลำดับของโหมด ทีฟ(R) การทำงานในแต่ละครึ่งไซเคิลของแรงดันเอาท์พุทเป็น ใหมดรีเจนเนอเรทีฟก่อนแล้วตามด้วยโหมดเพาเวอริ่ง ์ ซึ่งจะทำให้มีลำดับการนำกระแสขคงสวิทซ์มคสเฟท และไดโอดในกิ่งที่หนึ่งของวงจรอินเวอร์เตอร์เป็น <sub>D1</sub>-และมีลำดับการนำกระแสของสวิทช์  $S_1 - D'_1 - S'_1$ มคสเฟทและไดโคดในกิ่งที่สคงขคงวงจรคินเวคร์เตคร์ เป็น D'2-S'2-D2-S2 จากการที่ลำดับการนำกระแส ของสวิทช์มอสเฟทและไดโอดในแต่ละกิ่งเป็นเช่นนี้จะ ทำให้การเริ่มน้ำกระแสของสวิทช์มอสเฟทเกิดขึ้นขณะ แรงดันคร่อมสวิทช์มีค่าเท่ากับศูนย์ (zero voltage switching, ZVS) ตัวอย่างเช่น การเริ่มน้ำกระแสของ สวิทช์มอสเฟท  $\mathbf{S}_2$  ในโหมดเพาเวอริ่งของครึ่งไซเคิล

วงจร RLC อนุกรมในรูปที่ 5 จะเกิดเรโซแนนท์ ขึ้นเมื่อค่าความถี่(*w*<sub>s</sub>)ของแรงดันเอาท์พุททำให้ค่าค่า รีแอ็คแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนำเท่ากับค่ารีแอ็คแตนซ์ของ ตัวเก็บประจุ(*w*<sub>s</sub>*L*=1/*w*<sub>s</sub>*C*) ซึ่งจะทำให้ค่าอิมพีแดนซ์ ของวงจรมีค่าเท่ากับ *R* (*Z*=*R*) และความถี่ที่ทำให้ เกิดเรโซแนนท์นี้มีค่าดังสมการ

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{1}$$

หรือ

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{2}$$

เมื่อกำหนดให้ค่า characteristic impedance (*z*<sub>o</sub>) ของวงจรเรโซแนนซ์อนุกรมนี้เท่ากับ

$$Z_{0} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$= \omega_{0}L = \frac{1}{\omega_{0}C}$$
(3)

การเปลี่ยนแปลงของค่ารีแอ็คแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ (*x<sub>L</sub>*)และค่ารีแอ็คแตนซ์ของตัวเก็บประจุ(*x<sub>c</sub>*)เทียบ กับการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ขององค์ประกอบหลัก มูล (*f*<sub>1</sub>)ของแรงดันเอาท์พุทคลื่นสแควร์ซึ่งมีค่า เท่ากับความถี่การสวิทซ์ (*f<sub>s</sub>*) สามารถพิจารณา อ้างอิงกับ *z<sub>o</sub>* ได้ดังนี้

$$\frac{X_L}{Z_0} = \frac{\omega_s L}{\omega_0 L} = \frac{\omega_s}{\omega_0}$$
(4)

และ

$$\frac{-X_C}{Z_0} = \frac{(-1/\omega_s C)}{(1/\omega_0 C)} = -\frac{\omega_0}{\omega_s}$$
(5)

สามารถพล็อตกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า *x<sub>L</sub>/z<sub>o</sub>* และค่า -*x<sub>c</sub>/z<sub>o</sub>* เทียบกับอัตราส่วนความถี่

ลบของแรงดันเอาท์พุทดังแสดงในรูปที่ 4 จะเห็นว่า ก่อนหน้านั้นกระแสเอาท์พุทไหลผ่านไดโอด D<sub>2</sub> และ D' ทำให้มีแรงดันคร่อมสวิทช์มอสเฟท S<sub>2</sub> เท่ากับ ศูนย์ ดังนั้นขณะสวิทช์มอสเฟท S<sub>2</sub> เริ่มนำกระแสจะมี แรงดันคร่อมสวิทช์นี้เป็นศูนย์ นั่นหมายความว่าสวิทช์ มอสเฟทดังกล่าวทำงานภายใต้สภาวะ ZVS ซึ่งเป็น การทำงานที่ถูกต้อง

## การวิเคราะห์หากระแสและกำลังไฟฟ้า เอาท์พุท

จากการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทำให้ได้คลื่น แรงดันในลักษณะสแควร์ด้านเอาท์พุท(*v<sub>o</sub>*)มีความถี่ เท่ากับความถี่การสวิทช์(*f<sub>s</sub>*) จ่ายให้โหลดเรโซแน นท์อนุกรม สามารถแสดงวงจรด้านเอาท์พุทนี้ได้ดังรูป ที่ 5(ก) และแทนด้วยวงจรเฟเซอร์ที่องค์ประกอบคลื่น ไซน์ความถี่ *nw<sub>s</sub>* ใด ๆ ได้ดังรูปที่ 5(ข)



(ก) วงจรเรโซแนนท์อนุกรมด้านเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์



 (ข) วงจรเฟเซอร์ที่องค์ประกอบความถี่ n\omega\_s ใด ๆ รูปที่ 5 วงจรเรโซแนนท์อนุกรมและวงจรเฟเซอร์ด้านเอาท์พุท ของอินเวอร์เตอร์

หลักมูลของคลื่นแรงดันเอาท์พุทต่อความถี่เรโซแน นท์ของวงจร(f<sub>s</sub>/f<sub>o</sub>) ได้ดังรูปที่ 6 ซึ่งจะพบว่า x<sub>L</sub>/z<sub>o</sub> = x<sub>C</sub>/z<sub>o</sub> เมื่อความถี่หลักมูลของคลื่นแรงดัน เอาท์พุทเท่ากับความถี่เรโซแนนท์ของวงจร



รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงค่ารีแอ็คแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ $\left(rac{X_L}{Z_0}
ight)$ และตัวเก็บประจุ  $\left(rac{X_C}{Z_0}
ight)$ เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วน ความถี่  $f_s/f_0$ 

แรงดันเอาท์พุทคลื่นสแควร์จากอินเวอร์เตอร์ ที่จ่ายให้กับวงจรเรโซแนนท์อนุกรมในรูปที่ 5(ก) สามารถแสดงในรูปของอนุกรมฟูเรียร์ได้ดังสมการ

$$v_o = \frac{V_d}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (2 - 2\cos n\pi) \sin n\omega t$$
(6)

ค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ *ก๛*<sub>ร</sub> ใด ๆ ของวงจรเรโซแน นท์อนุกรมดังรูปที่ 5(ข) สามารถแสดงได้ดังสมการ

$$\mathbf{Z}_{n} = R + j \left( n \omega_{s} L - \frac{1}{n \omega_{s} C} \right)$$
  
$$= Z_{0} \left[ \frac{1}{Q} + j \left( \frac{n \omega_{s}}{\omega_{0}} - \frac{\omega_{0}}{n \omega_{s}} \right) \right]$$
(7)

โดยที่ค่า Quality factor (Q) ของวงจรเรโซแนนท์อนุ กรมมีความสัมพันธ์ดังสมการ

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$
(8)

จะได้ขนาดของอิมพีแดนซ์ใน (7) มีค่าดังสมการ

$$Z_n = Z_0 \sqrt{\frac{1}{Q^2} + \left(\frac{n\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{n\omega}\right)^2}$$
(9)

และมุมของอิมพีแดนซ์เท่ากับ

$$\theta_n = \tan^{-1} \left[ Q \left( \frac{n\omega_s}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{n\omega_s} \right) \right]$$
 (10)

ค่า normalized ของขนาดอิมพี่แดนซ์เท่ากับ

$$\frac{Z_n}{Z_0} = \sqrt{\frac{1}{Q^2} + \left(\frac{n\omega_s}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{n\omega_s}\right)^2}$$
(11)

กำหนดให้อินเวอร์เตอร์ทำงานที่ความถี่การสวิทช์สูง กว่าความถี่เรโซแนนท์  $f_s > f_0$  สามารถแสดง เส้นกราฟเป็นค่า normalized ของอิมพีแดนซ์ของ องค์ประกอบหลักมูลในขณะที่ความถี่เปลี่ยนแปลงที่ ค่า Q ต่าง ๆ จากสมการ (11) ได้ดังรูปที่ 7 ซึ่งจะเห็น ได้ว่าเมื่อความถี่ของการสวิทช์สูงขึ้นจะส่งผลทำให้ค่า อิมพีแดนซ์สูงขึ้นตาม ในขณะที่ค่า Q สูงขึ้นจะส่งผล ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของขนาดอิมพีแดนซ์เร็ว กว่าและขนาดอิมพีแดนซ์มีค่าต่ำลง



รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า normalized ของอิมพีแดนซ์ ขององค์ประกอบหลักมูลและอัตราส่วนความถี่ f<sub>s</sub>/f<sub>0</sub>

มุมอิมพีแดนซ์ซึ่งเท่ากับมุมต่างเฟสระหว่าง องค์ประกอบหลักมูลของคลื่นแรงดันและกระแส เอาท์พุทในสมการ (10) เมื่อนำมาพล็อตกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างมุมอิมพีแดนซ์นี้เทียบกับ อัตราส่วนความถี่  $f_s/f_o$  จะได้เส้นกราฟดังรูปที่ 8 จะ เห็นได้ว่าเมื่อความถี่การสวิทซ์สูงขึ้นจะส่งผลทำให้มุม อิมพีแดนซ์มีค่าสูงขึ้นตามและมีค่าเป็นบวก ซึ่งส่งผล ทำให้องค์ประกอบหลักมูลของกระแสเอาท์พุท ( $i_{o1}$ ) มีเฟสล้าหลังองค์ประกอบหลักมูลของแรงดันเอาท์พุท ( $v_{o1}$ ) มากขึ้น และมุมอิมพีแดนซ์นี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อความถี่การสวิทซ์เท่ากับความถี่เรโซแนนท์พอดีทำ ให้กระแส  $i_{o1}$  มีเฟสตรงกันกับแรงดัน  $v_{o1}$  ในขณะที่ ค่า Q สูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของมุม อิมพีแดนซ์เข้าใกล้ 90° เร็วขึ้น



รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมอิมพีแดนซ์และอัตราส่วน ความถี่  $f_s/f_0$ 

จากองค์ประกอบต่างๆ ของคลื่นแรงดันเอาท์พุทใน (6) ขนาดและมุมของอิมพีแดนซ์ใน (9) และ (10) ตามลำดับ สามารถนำมาคำนวณหาองค์ประกอบ ต่างๆ ของคลื่นกระแสเอาท์พุทได้ดังสมการ

$$i_o = \frac{V_d}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nZ_n} (2 - 2\cos n\pi) \sin(n\omega_s t - \theta_n) \qquad (12)$$

จากสมการของกระแสเอาท์พุทที่ได้นี้นำไปสู่การ คำนวณหาแรงดันคร่อมตัวเหนี่ยวนำเรโซแนนท์นี้ได้ดัง สมการ

$$v_L = \frac{V_d}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{Z_n} \left( 2 - 2\cos n\pi \right) \omega_s L \sin \left( n\omega_s t - \theta_n + \frac{\pi}{2} \right)$$
(13)

และคำนวณหาแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุเรโซแนนท์ข องวงจรได้ดังสมการ

$$v_{c} = \frac{V_{d}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2} Z_{n} \omega_{s} C} \left(2 - 2\cos n\pi\right) \sin\left(n\omega_{s} t - \theta_{n} - \frac{\pi}{2}\right) (14)$$

แรงดันเอาท์พุท $(v_o)$  ในสมการ (6) กระแสเอาท์พุท $(i_o)$  ในสมการ (12) แรงดันคร่อมตัวเหนี่ยวนำเร

โซแนนท์  $(v_L)$  ในสมการ (13) และแรงดันคร่อมตัว เก็บประจุเรโซแนนท์  $(v_C)$  ในสมการ (14) สามารถ แสดงลักษณะคลื่นของแรงดันและกระแสในสมการ เหล่านี้ได้ดังรูปที่ 9 ซึ่งสามารถมองวงจร RLC อนุกรม เป็นโหลดอินดัคทีฟเนื่องจากค่ารีแอ็คแตนซ์ของตัว เก็บประจุเรโซแนนท์ต่ำกว่าค่ารีแอ็คแตนซ์ของตัว เหนี่ยวนำเรโซแนนท์ ส่งผลทำให้องค์ประกอบหลักมูล ของกระแสเอาท์พุท  $(i_{o1})$  มีเฟสล้าหลังองค์ประกอบ หลักมูลของแรงดันเอาท์พุท  $(v_{o1})$  เท่ากับ  $\theta_1$ 



รูปที่ 9 ลักษณะคลื่นแรงดันและกระแสตามจุดต่าง ๆ ใน วงจรเรโซแนนท์อนุกรม

จากคลื่นแรงดันและกระแสในวงจรเรโซแน นท์อนุกรมที่แสดงไว้ในรูปที่ 9 ถึงแม้ว่าแรงดันเอาท์พุท ของวงจรจะมีลักษณะเป็นคลื่นสแควร์ แต่จะได้กระแส เอาท์พุทมีลักษณะคลื่นใกล้เคียงไซน์ เนื่องจากเมื่อ พิจารณาจากขนาดของอิมพีแดนซ์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ความถี่ในกราฟรูปที่ 7 พบว่าขนาดอิมพีแดนซ์มีค่า ต่ำสุดเมื่อ  $f_s = f_0$  และมีค่าสูงขึ้นเมื่อ  $f_s > f_0$  นั่น หมายความว่าเมื่อแรงดันเอาท์พุทคลื่น สแควร์มี ความถี่เท่ากับความถี่เรโซแนนท์หรือต่างจากความถี่เร โซแนนท์เล็กน้อย ทำให้ขนาดของอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ หลักมูล (Z<sub>1</sub>) มีค่าต่ำและขนาดของอิมพีแดนซ์ที่ ความถี่ฮาร์โมนิกส์ (Z<sub>3</sub>, Z<sub>5</sub>, Z<sub>7</sub>, . . .) มีค่าสูง ส่งผล ทำให้องค์ประกอบหลักมูลของกระแสเอาท์พุทไหล ผ่านวงจรได้ดี ในขณะที่องค์ประกอบฮาร์โมนิกส์ของ กระแสเอาท์พุทไหลผ่านวงจรได้น้อยมาก

จากองค์ประกอบต่าง ๆ ของกระแสเอาท์พุท ในสมการ (12) สามารถคำนวณหาค่าแอมปลิจูดของ กระแสนี้ที่เป็นฟังก์ชั่นของค่า *Q* และความถี่หลักมูล ซึ่งเท่ากับความถี่การสวิทช์(*ω*,) ได้ดังสมการ

$$I_{m} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{V_{d}}{n\pi Z_{n}} (2 - 2\cos n\pi) \right)^{2}}$$

$$= \frac{V_{d}}{\pi Z_{0}} \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(2 - 2\cos n\pi)^{2}}{n^{2} \left[ \frac{1}{Q^{2}} + \left( \frac{n\omega_{s}}{\omega_{0}} - \frac{\omega_{0}}{n\omega_{s}} \right)^{2} \right]} \right)}$$

$$(15)$$

และจะได้ค่า normalized ของกระแสเอาท์พุทนี้ดัง สมการ

$$\frac{I_m Z_0}{V_d} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\left(2 - 2\cos n\pi\right)^2}{n^2 \left[\frac{1}{Q^2} + \left(\frac{n\omega_s}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{n\omega_s}\right)^2\right]} \right)}$$
(16)



รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า normalized ของกระแส เอาท์พุท  $\left(rac{I_m Z_0}{V_d}
ight)$  และอัตราส่วนความถี่  $f_s/f_0$ 

ค่า normalized ของกระแสเอาท์พุทในสมการ (16) เมื่อพล็อตเทียบกับอัตราส่วนของความถี่  $f_s/f_0$  ใน ย่านจาก 1 ถึง 1.5 ที่ค่า Q ต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดัง รูปที่ 10 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ากระแสเอาท์พุทของวงจรจะ มีค่าสูงสุดเมื่อความถี่หลักมูลของแรงดันเอาท์พุท เท่ากับความถี่เรโซแนนท์ของวงจรและมีค่าแปรผัน ตามค่า Q ของวงจร

สามารถคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุท ของอินเวอร์เตอร์นี้ได้จากผลรวมของกำลังไฟฟ้าที่เกิด จากองค์ประกอบหลักมูลและองค์ประกอบฮาร์โมนิกส์ ของกระแสดังสมการ

$$P_{o} = \sum_{n=1}^{\infty} (I_{o,rms,n}^{2}R)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{V_{d}}{\sqrt{2}n\pi Z_{n}} (2 - 2\cos n\pi) \right)^{2} R$$

$$= \frac{V_{d}^{2}R}{2\pi^{2}Z_{0}^{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(2 - 2\cos n\pi)^{2}}{n^{2} \left[ \frac{1}{Q^{2}} + \left( \frac{n\omega_{s}}{\omega_{0}} - \frac{\omega_{0}}{n\omega_{s}} \right)^{2} \right]} \right)$$
(17)

ซึ่งจะได้ค่า normalized ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทนี้ เท่ากับ

$$\frac{P_{o}Z_{0}^{2}}{V_{d}^{2}R} = \frac{1}{2\pi^{2}}\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(2-2\cos n\pi)^{2}}{n^{2} \left[ \frac{1}{Q^{2}} + \left( \frac{n\omega_{s}}{\omega_{0}} - \frac{\omega_{0}}{n\omega_{s}} \right)^{2} \right]} \right)$$
(18)

ค่า normalized ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทในสมการ (18) เมื่อพล็อตเทียบกับอัตราส่วนของความถี่ f<sub>s</sub> / f<sub>0</sub> ในย่านจาก 1 ถึง 1.5 ที่ค่า Q ต่าง ๆ สามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่าค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุทจะมี ค่าสูงสุดเมื่อความถี่หลักมูลของแรงดันเอาท์พุท เท่ากับความถี่เรโซแนนท์ของวงจรและมีค่าลดลงเมื่อ ความถี่หลักมูลของแรงดันเอาท์พุทมีค่าสูงขึ้น ดังนั้น จึงสามารถปรับลดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทของวงจร อินเวอร์เตอร์นี้ได้โดยการปรับเพิ่มความถี่หลักมูลของ แรงดันเอาท์พุทซึ่งทำได้โดยการปรับเพิ่มความถี่การ สวิทช์ของอินเวอร์เตอร์นั่นเอง



รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า normalized ของกำลัง ไฟฟ้าเอาท์พุท ( $P_oZ_0^2/V_d^2R$ ) และอัตราส่วน  $f_s/f_0$ 

### 4. ผลการจำลองแบบและการทดลอง

เมื่อทำการทดสอบเครื่องต้นแบบของ อินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์จ่ายโหลดเรโซแนนท์อนุกรมที่ ออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดัง แสดงในตารางที่ 1 สามารถแสดงลักษณะคลื่นของ แรงดันเอาท์พุท $(v_o)$  และกระแสเอาท์พุท  $(i_o)$  โดย เปรียบเทียบกับผลการจำลองแบบด้วยโปรแกรม PSPICE ที่ความถี่การสวิทช์เท่ากับ 60 kHz, 65 kHz, 70 kHz และ 75 kHz ได้ดังรูปที่ 12, 13, 14 และ 15 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 พารามเตอร์ทไข้สำหรับการจาลองแบบและการ			
ทดลอง			
Experimental parameters		Actual values	
MOSFET	$V_{DSS}$	500 V	
	$I_D$	20 A	
IKFP400	$R_{DS(ON)}$	0.27 Ω	
Resonant capacitor, C		0.044 <i>µ</i> F	
Resonant inductor, L		170 <i>µ</i> H	
Load resistor, R		25 Ω	
Resonant frequency, $f_0$		58.39 kHz	
Quality factor, Q		2.49	
DC link voltage, $V_d$		200 V	
$V_o$ Simulation $i_o$ $f_s = 60 \text{ kHz}$		CH1=100V CH2=1V DC 10001 DC 1:1 Vo	2us/div (2us/div) Norsa:100MS/s Experiment
		io	
		$f_{\rm s} = 60  \rm kHz$	
		=Tracc1= Max 200.0V R =Tracc2= Max 920.0mV R	\$ 192.3V Frieq s 669.8mV Frieq
(ก) การจำลองแบบ		(ข) การทดลอง	
รูปที่ 12 คลื่นของแรงดันเอาท์พุท( $v_o$ )และกระแสเอาท์พุท( $i_o$ )			
ขณะ <sub>fs</sub> = 60 kHz สเกล : 100 V/Div, 10 A/Div, 2			

 $\mu$ s/Div





รูปที่ 13 คลื่นของแรงดันเอาท์พุท(<sub>v₀</sub>)และกระแสเอาท์พุท(*i₀*)

ขณะ <sub>fs</sub> = 65 kHz สเกล : 100 V/Div, 10 A/Div, 2

µ/s/Div



รูปที่ 14 คลื่นของแรงดันเอาท์พุท(v<sub>a</sub>)และกระแสเอาท์พุท(i<sub>a</sub>) ขณะ <sub>fs</sub> = 70 kHz สเกล : 100 V/Div, 10 A/Div, 2 µ/s/Div



 $\mu$ s/Div

และเมื่อใช้สมการกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทที่เป็นฟังก์ชั่น ของความถี่การสวิทช์ที่ได้วิเคราะห์ไว้ใน (17) นำมา คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์ใน ย่านความถี่การสวิทช์สูงกว่าความถี่เรโซแนนท์ในย่าน kHz สามารถพล็อตกราฟแสดงการ 80 60 เปลี่ยนแปลงของค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุทนี้ได้ดังรูปที่

16 พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องของหลักการวิเคราะห์ ที่นำเสนอด้วยผลการทดลองซึ่งได้แสดงไว้ในกราฟรูป เดียวกัน



รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าเอาท์พุท ( $P_o$ ) และความถี่การสวิทช์ ( $f_s$ )

### 5. สรุป

จากการวิเคราะห์วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อ นุกรมแบบเต็มบริดจ์ที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยการปรับ ความถี่การสวิทช์พร้อมสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อ ทดสอบยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีที่นำเสนอ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

(1) การปรับลดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทของเรโซแนนท์ อินเวอร์เตอร์ด้วยวิธีปรับเพิ่มความถี่การสวิทซ์จะต้อง ปรับความถี่การสวิทช์ในย่านที่สูงกว่าความถี่เร โซแนนท์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์สวิทช์ของ อินเวอร์เตอร์เริ่มนำกระแสขณะแรงดันเป็นศูนย์

(2) เมื่อปรับความถี่การสวิทช์ของอินเวอร์เตอร์ให้ สูงขึ้นในย่านที่สูงกว่าความถี่เรโซแนนท์จะทำให้แอม ปลิจูดของกระแสเอาท์พุทมีค่าต่ำลงพร้อมทั้งมุมเฟส ของกระแสเอาท์พุทจะล้าหลังแรงดันเอาท์พุทมากขึ้น ส่งผลทำให้กำลังไฟฟ้าเอาท์พุทมีค่าลดลง (3) เมื่อทำการปรับความถี่การสวิทซ์ของ
 อินเวอร์เตอร์ต้นแบบในย่านจาก 60 – 80 kHz จะ
 ส่งผลทำให้กำลังไฟฟ้าเอาท์พุทลดลงจาก 1300-370
 W

### เอกสารอ้างอิง

- [1] Marian K. Kazimierczuk and Dariusz Czarkowski, Resonant Power Converters. John Wiley & Sons, 1995.
- [2] Robert W. Erickson and Dragan Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics. Kluwer Academic Publishers, 2001.
- [3] D. W. Hart, Introduction to Power Electronic. Prentice-Hall, 1997.
- [4] Marian K. Kazimierczuk, "Class D Voltage-Switching MOSFET Power Amplifier," IEE Proceedings-B, Vol. 138, No. 6, pp. 285-296, November 1991.
- [5] P. Viriya, N. Yongyuth and K. Matsuse, "Analysis of Two Continuous Control Regions of Conventional Phase Shift and Transition Phase Shift for Induction Heating Inverter under ZVS and NON-ZVS Operation," IEEE Trans. Power Electron., Vol. 23, No. 6, pp. 2794-2805, 2008.
- [6] S. Llorente, F. Monterde, J. M. Burdio and J. Acero, "A Comparative Study of Resonant Inverter Topologies Used in Induction Cookers," Applied Power Electronics

Conference and Exposition (APEC 2002), pp. 1168-1174, 2002.

- [7] J. M. Burdio, L. A. Barragan, F. Monterde, D. Navarro, and J. Acero, "Asymmetrical Voltage-Cancellation Control for Full-Bridge Series Resonant Inverter," IEEE Trans. Power Electron., Vol. 19, No. 2, pp. 461-469, 2004.
- [8] L. Grajales and F. C. Lee, "Control System Design and Small Signal Analysis of a Phase-Shift-Controlled Series-Resonant Inverter for Induction Heating," Proceeding of Power Electronics Specialist Conference (PESC'95), pp. 450-456, 1995.